Final datasheet

Eigenschaften



- Elektrische Eigenschaften
  - V_{DSS} = 1400 V
  - I_{DN} = 850 A / I_{DRM} = 1700 A
  - Siliziumkarbid-MOSFET mit .XT
  - Niedriger $R_{DS,on}$
  - Niedrige Schaltverluste
  - Niederinduktives Design
  - $T_{vj\ op}$ = 175°C
- Mechanische Eigenschaften
  - Hohe Powercyclingfestigkeit durch .XT
  - Große Luft- und Kriechstrecken
  - Hohe Vibrationsfestigkeit
  - PinFin Bodenplatte für direkte Flüssigkeitskühlung
  - Integrierter Temperatursensor
  - Hochstromanschlüsse für Laserschweißen
  - Steueranschlüsse mit PressFIT Technologie
  - RoHS konform

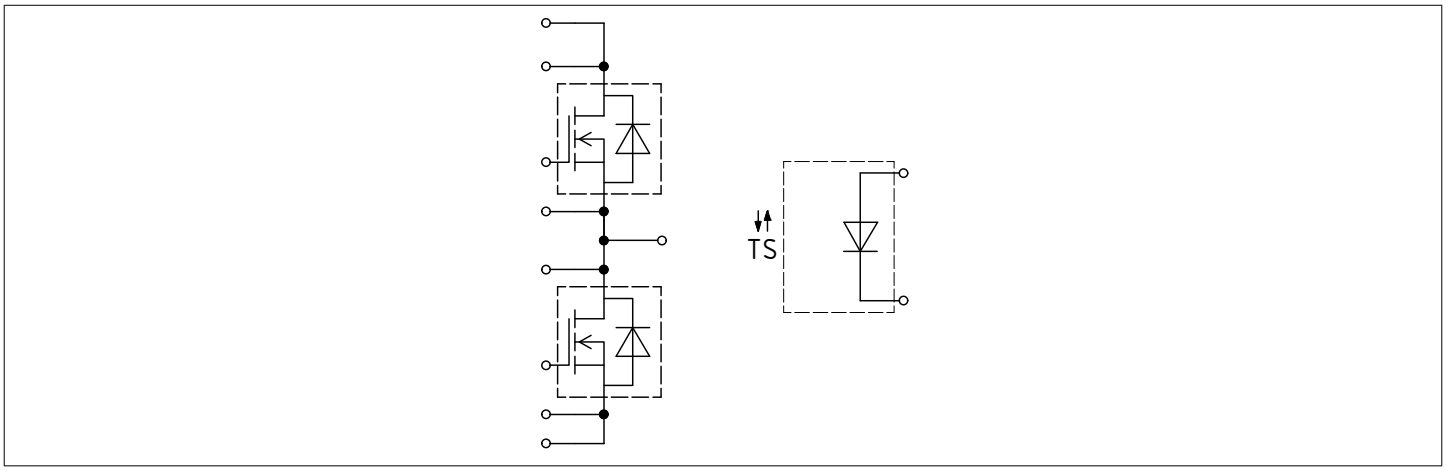
Potenzielle Anwendungen

- CAV Elektrischer Antriebsstrang für On-Road-Fahrzeuge

Produktvalidierung

- Qualified according to AQG 324, release no.: 03.1/2021
- Vibrationsfestigkeit qualifiziert entsprechend ISO 16750-3
- Qualifiziert entsprechend IPC-9797

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	**Gehäuse**	3
2	**MOSFET**	4
3	**Body diode (MOSFET)**	6
4	**Temperatursensor**	7
5	**Kennlinien**	8
6	**Schaltplan**	16
7	**Gehäuseabmessungen**	17
8	**Modul-Label-Code**	18
	Änderungshistorie	19
	Disclaimer	20

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	3.4	kV
Material Modulgrundplatte			Cu+Ni[1)]	
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Si_3N_4	
Kriechstrecke	$d_{Creep\ min}$	Kontakt - Bodenplatte, min., (PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)	16.6	mm
Kriechstrecke	$d_{Creep\ min}$	Kontak - Kontakt, min., (PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)	17.6	mm
Luftstrecke	$d_{Clear\ min}$	Kontakt - Bodenplatte, min.	14.0	mm
Luftstrecke	$d_{Clear\ min}$	Kontak - Kontakt, min.	13.2	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		175	

1) Ni plated Cu baseplate.

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Druckabfall im Kühlkreislauf[1)]	Δp	$\Delta V/\Delta t$ = 10.0 dm³/min, 50% water / 50% ethylenglycol, T_F = 60 °C			102		mbar
Maximum pressure in cooling circuit	p					3	bar
Modulstreuinduktivität	L_{sDS}				6.5		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{DD'+SS'}$	T_F = 25 °C, pro Schalter			0.4		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		125	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur	T_{BPmax}					150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift[2)]	PCB to frame, EJOT Delta PT, Schraube	0.45		0.55	Nm
			baseplate to heatsink, M4 8.8, Schraube	1.8		2.3	
Gewicht	G				435		g

1) Design of the heat sink, flow rate and flow direction of the coolant according to application note AN-2026-04 "HybridPACK HD Application and Mounting Instructions".
2) AN-2026-04 "HybridPACK HD Application and Mounting Instructions".

2 MOSFET

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}		T_{vj} = -40...175 °C	1400	V
Implementierter Drain-Strom	I_{DN}			850	A
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_F = 65 °C	785[1)]	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		1700	A
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}			-10...23	V
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}			-7...20	V

1) calculated with typical $R_{th,JF}$ + 4.5 $\sigma_{Rth,JF}$.

Tabelle 4 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...-3	V

Tabelle 5 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	I_D = 850 A	V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 25 °C		1.16	1.58	mΩ
			V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 125 °C		1.77		
			V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 175 °C		2.26		
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 25 °C		1	1.36	
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 125 °C		1.65		
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 175 °C		2.15		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	I_D = 310 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V)		3.05	3.95	4.75	V
Gateladung	Q_G	V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3...18 V, T_{vj} = 25 °C			2.2		µC

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0.17		Ω
Eingangskapazität	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 750 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		74.1		nF
Ausgangskapazität	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 750 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		2.6		nF
Rückwirkungskapazität	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS} = 750 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.2		nF
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	V_{DS} = 750 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			974		µJ
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	V_{DS} = 1400 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C			900	µA
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS} = 20 V			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\,on}$	I_D = 850 A, R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 V_{GS} to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		87		ns
			T_{vj} = 125 °C		73		
			T_{vj} = 175 °C		63		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_D = 850 A, R_{Gon} = 4.7 Ω, V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 I_D to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		85		ns
			T_{vj} = 125 °C		79		
			T_{vj} = 175 °C		77		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\,off}$	I_D = 850 A, R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 V_{GS} to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		188		ns
			T_{vj} = 125 °C		201		
			T_{vj} = 175 °C		201		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_D = 850 A, R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 I_D to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		40		ns
			T_{vj} = 125 °C		40		
			T_{vj} = 175 °C		42		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_D = 850 A, V_{DD} = 750 V, L_σ = 8 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 4.7 Ω, di/dt = 12.4 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		57.1		mJ
			T_{vj} = 125 °C		59.7		
			T_{vj} = 175 °C		62.7		
Einschaltverlustenergie pro Puls, optimiert	$E_{on,o}$	I_D = 850 A, V_{DD} = 750 V, L_σ = 8 nH, V_{GS} = -3/18 V, $R_{Gon,o}$ = 3.9 Ω, di/dt = 14.5 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		44.4		mJ
			T_{vj} = 125 °C		42.4		
			T_{vj} = 175 °C		43.1		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_D = 850 A, V_{DD} = 750 V, L_σ = 8 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 1 Ω, dv/dt = 17.6 kV/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		26.6		mJ
			T_{vj} = 125 °C		26.6		
			T_{vj} = 175 °C		26.1		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	V_{GS} = -3/18 V, V_{DD} = 750 V, $V_{DSmax} = V_{DSS}-L_{sDS}*di/dt$[1)]	$t_P \leq 1.2$ µs, T_{vj} = 175 °C		10500		A
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	V_{GS} = -3/15 V, V_{DD} = 750 V, $V_{DSmax} = V_{DSS}-L_{sDS}*di/dt$[1)]	$t_P \leq 2$ µs, T_{vj} = 175 °C		8700		A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühl-Flüssigkeit	R_{thJF}	pro MOSFET, ΔV/Δt = 10 dm^3/min, Kühlflüssigkeit = 50% water / 50% ethylenglycol, T_F = 60 °C			58.5		K/kW
Standard deviation of thermal resistance, junction to cooling fluid	$\sigma_{Rth,JF}$	ΔV/Δt = 10 dm^3/min, Kühlflüssigkeit = 50% water / 50% ethylenglycol, T_F = 60 °C			0.48		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$			-40		175	°C

1) Recommended short-circuit turn-off with -di/dt $_{90\%-10\%}$ ≥ 19 kA/µs.

***Anmerkung**:Die Wahl der positiven und negativen Gate-Source-Spannungen hat Auswirkungen auf die Verluste und das Langzeitverhalten des MOSFET und der Body-Diode. Die in der Application Note AN-2025-02 "CoolSiC™ MOSFET M2 in Easy modules" beschriebenen Design-Richtlinien müssen berücksichtigt werden, um einen einwandfreien Betrieb des Bauelements über die geplante Lebensdauer zu gewährleisten.*

3 Body diode (MOSFET)

Tabelle 6 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_F = 65 °C	450	A
Body Diode-gepulster Strom	$I_{SD\ pulse}$			1700	A
Grenzlastintegral	I^2t	V_{DS} = 0 V, V_{GS} = -3 V, t_P = 10 ms	T_{vj} = 175 °C	24.5	kA^2s

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_{SD}	I_{SD} = 850 A, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		4.47	5.65	V
			T_{vj} = 125 °C		4.06		
			T_{vj} = 175 °C		3.93		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 7 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Rückstromspitze	I_{rrm}	I_{SD} = 850 A, di_s/dt = 13 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		235		A
			T_{vj} = 125 °C		417		
			T_{vj} = 175 °C		513		
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	I_{SD} = 850 A, di_s/dt = 13 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		20.2		µC
			T_{vj} = 125 °C		32		
			T_{vj} = 175 °C		38.4		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	I_{SD} = 850 A, di_s/dt = 13 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		1.6		mJ
			T_{vj} = 125 °C		5.4		
			T_{vj} = 175 °C		8.2		
Abschaltenergie pro Puls, optimiert	$E_{rec,o}$	I_{SD} = 850 A, di_s/dt = 14.8 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		1.6		mJ
			T_{vj} = 125 °C		3.3		
			T_{vj} = 175 °C		5.1		

4 Temperatursensor

Tabelle 8 Charakteristische Werte

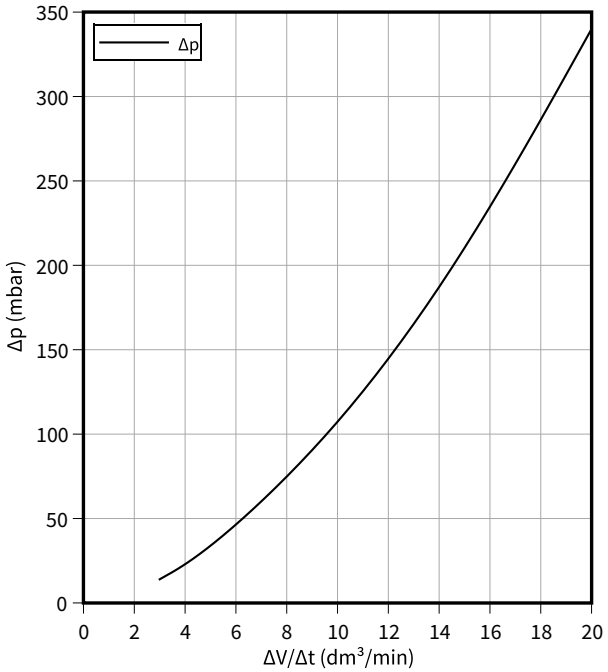
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Transienter Messstrom	I_{TS}					10	mA
Durchlassspannung	V_{TS}		I_{TS} = 0.2 mA, T_{vj} = 25 °C	2.574	2.624	2.674	V
			I_{TS} = 0.2 mA, T_{vj} = 85 °C	2.169	2.234	2.299	

5 Kennlinien

Druckabfall im Kühlkreislauf, Gehäuse

$\Delta p = f(\Delta V/\Delta t)$

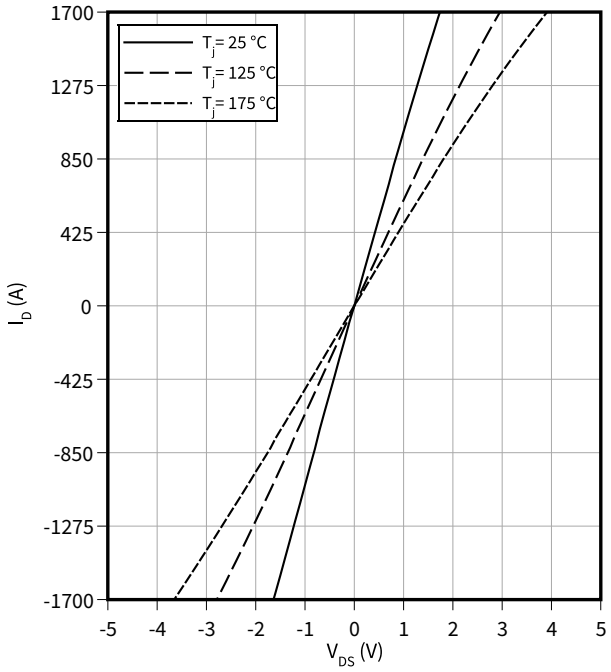
T_F = 60 °C, 50% water / 50% ethylenglycol



Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$

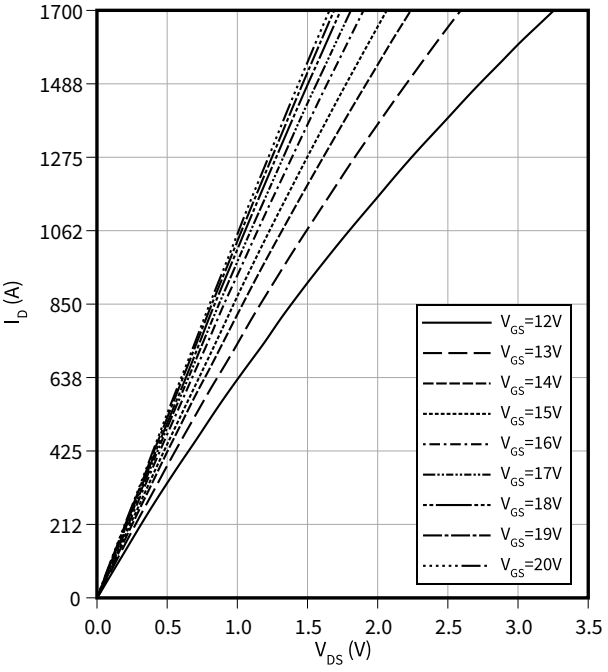
V_{GS} = 18 V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$

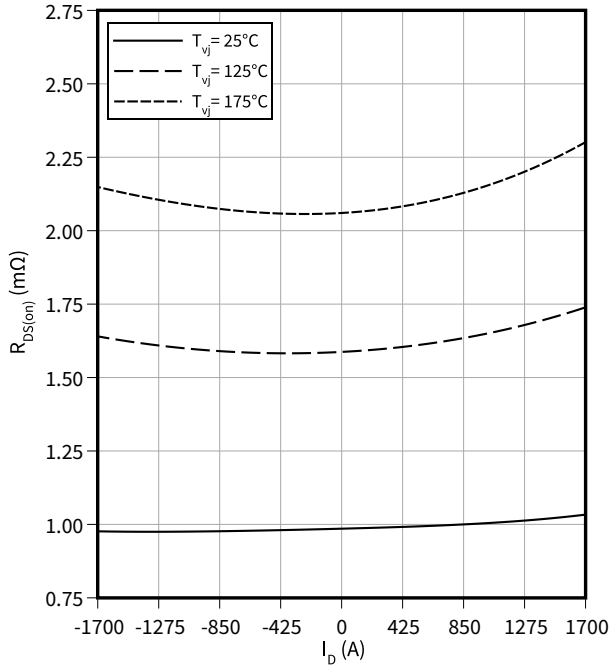
T_{vj} = 25 °C



Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

$R_{DS(on)} = f(I_D)$

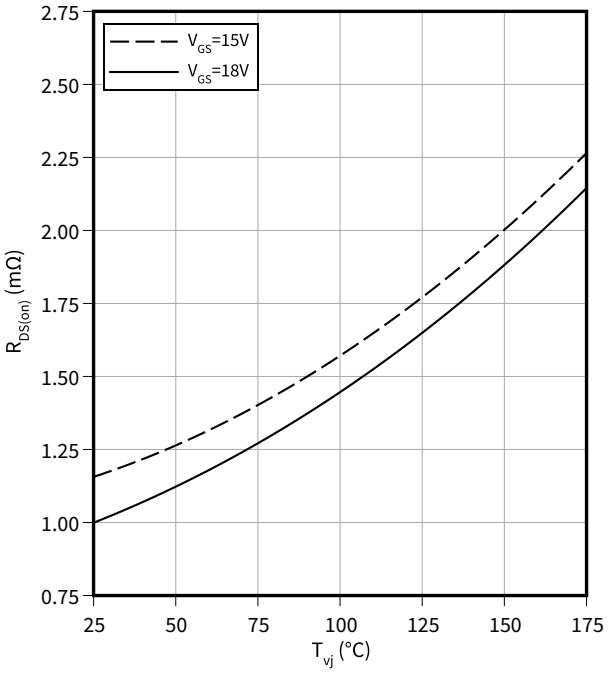
V_{GS} = 18 V



Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$

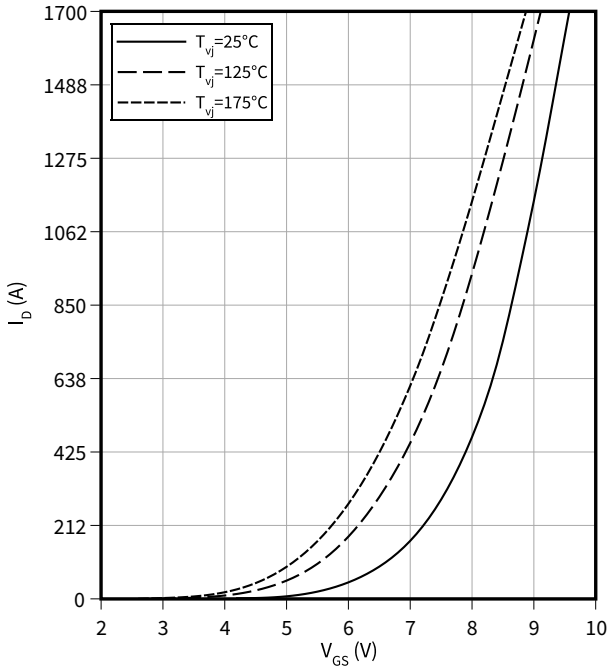
$I_D = 850$ A



Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{GS})$

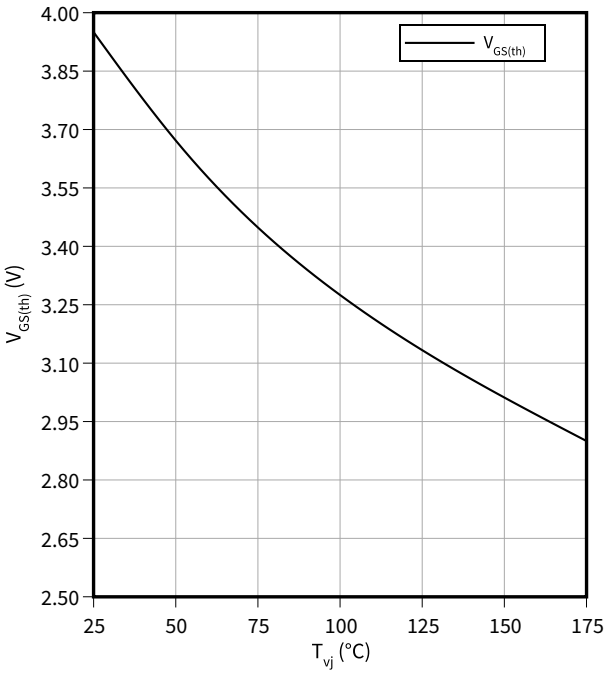
$V_{DS} = 20$ V



Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$

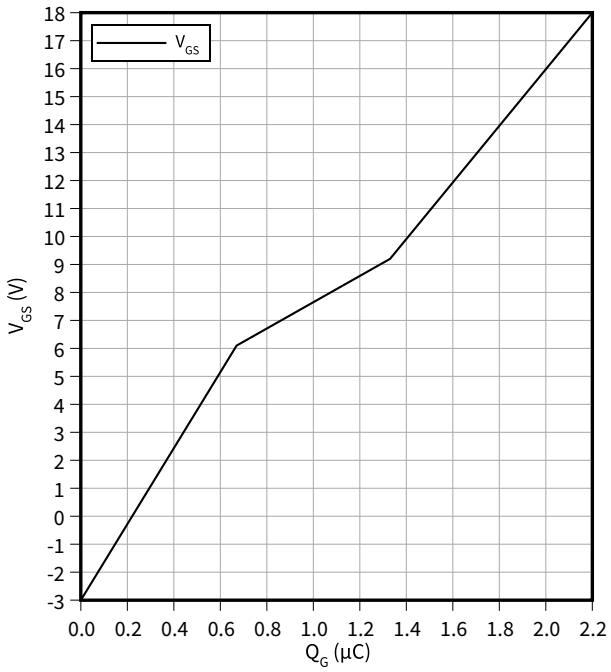
$I_D = 310$ mA, $V_{GS} = V_{DS}$



Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET

$V_{GS} = f(Q_G)$

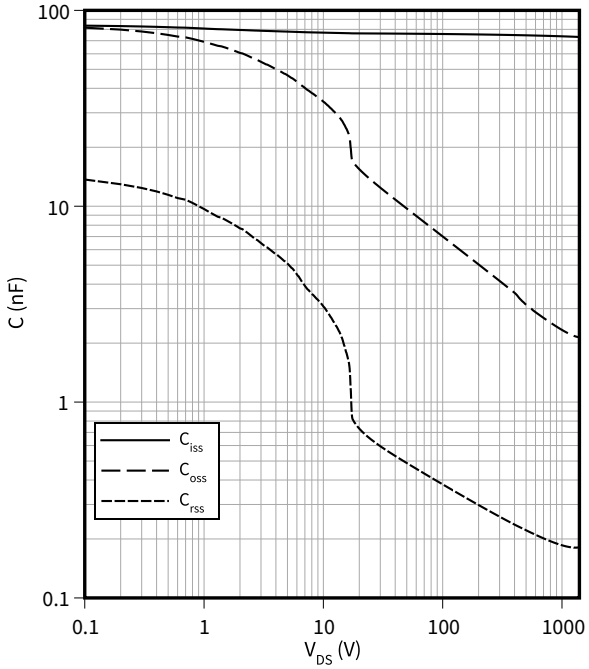
$I_D = 850$ A, $T_{vj} = 25$ °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET

$C = f(V_{DS})$

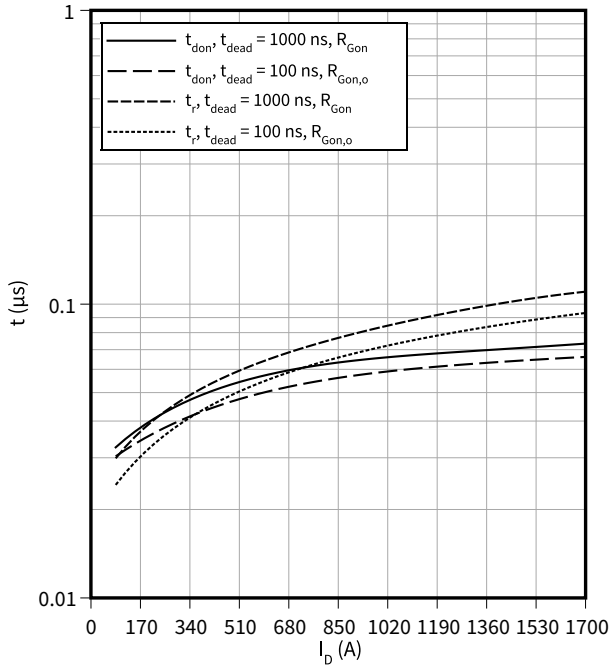
$f = 100\ kHz$, $T_{vj} = 25\ °C$, $V_{GS} = 0\ V$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$t = f(I_D)$

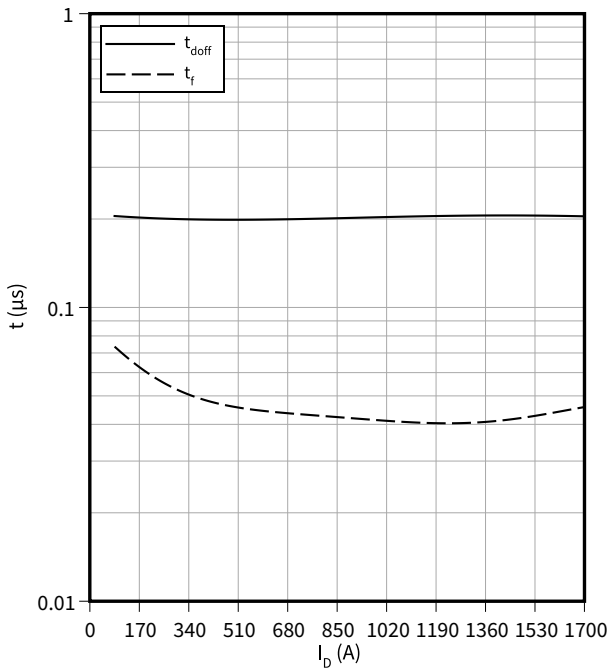
$V_{DD} = 750\ V$, $R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $R_{Gon,o} = 3.9\ \Omega$, $T_{vj} = 175\ °C$, $V_{GS} = -3/18\ V$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$t = f(I_D)$

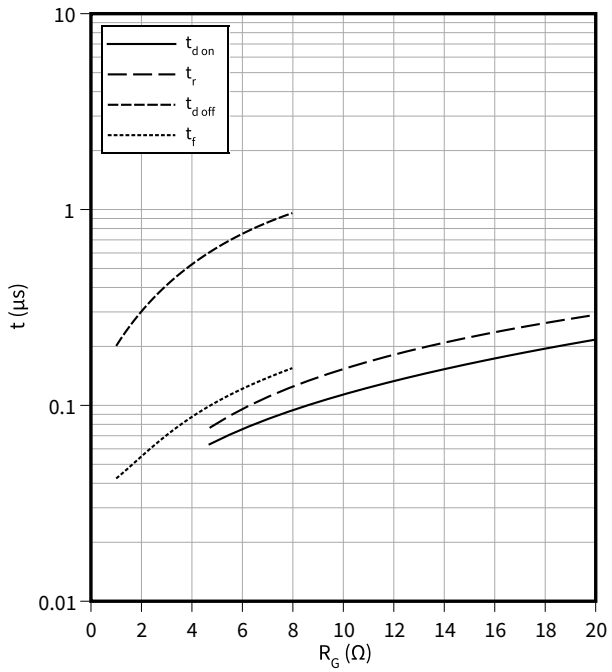
$R_{Goff} = 1\ \Omega$, $V_{DD} = 750\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$, $V_{GS} = -3/18\ V$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$t = f(R_G)$

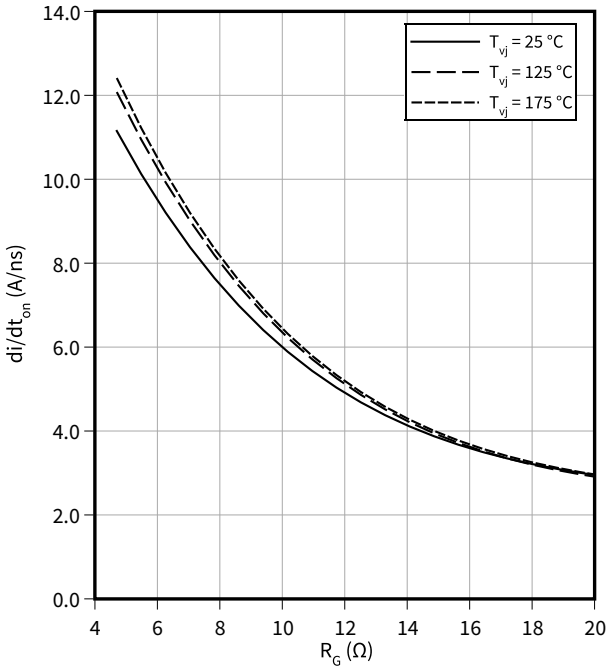
$V_{DD} = 750\ V$, $t_{dead} = 1000\ ns$, $I_D = 850\ A$, $T_{vj} = 175\ °C$, $V_{GS} = -3/18\ V$



Stromsteilheit (typisch), MOSFET

$di/dt_{on} = f(R_G)$

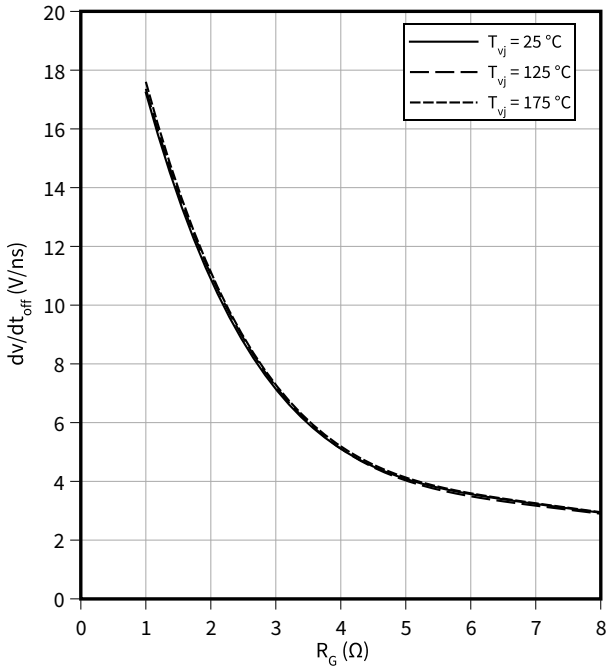
V_{DD} = 750 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 850 A, V_{GS} = -3/18 V



Spannungssteilheit (typisch), MOSFET

$dv/dt_{off} = f(R_G)$

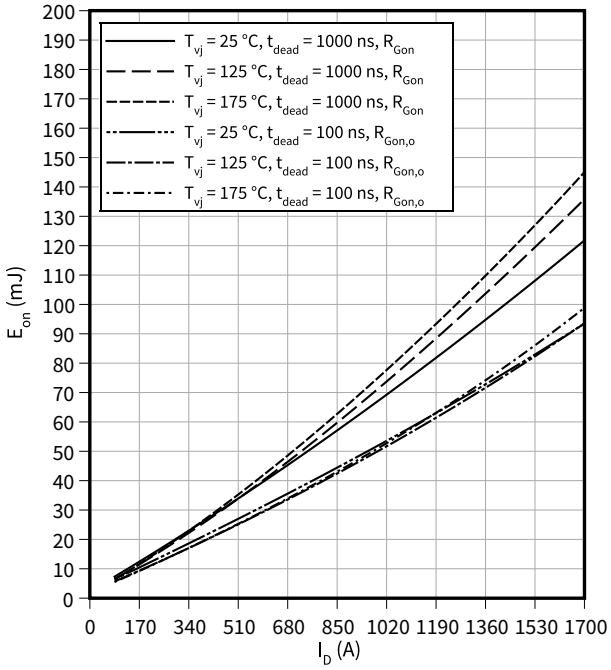
V_{DD} = 750 V, I_D = 850 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E_{on} = f(I_D)$

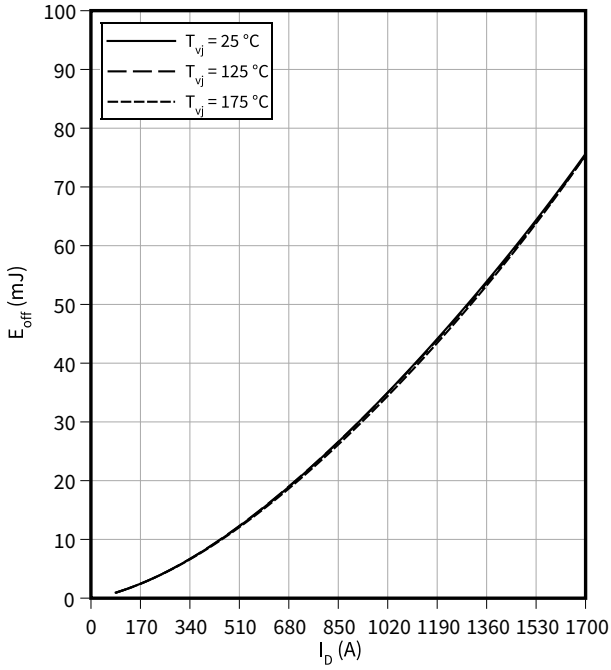
V_{DD} = 750 V, R_{Gon} = 4.7 Ω, $R_{Gon,o}$ = 3.9 Ω, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E_{off} = f(I_D)$

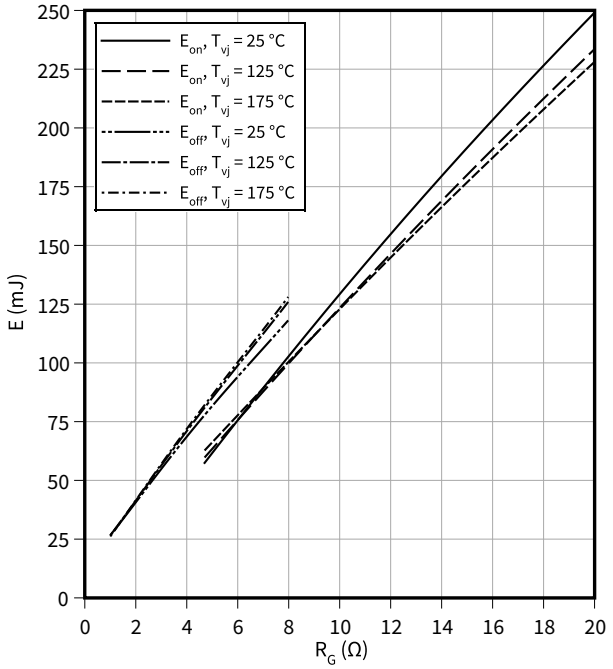
R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E = f(R_G)$

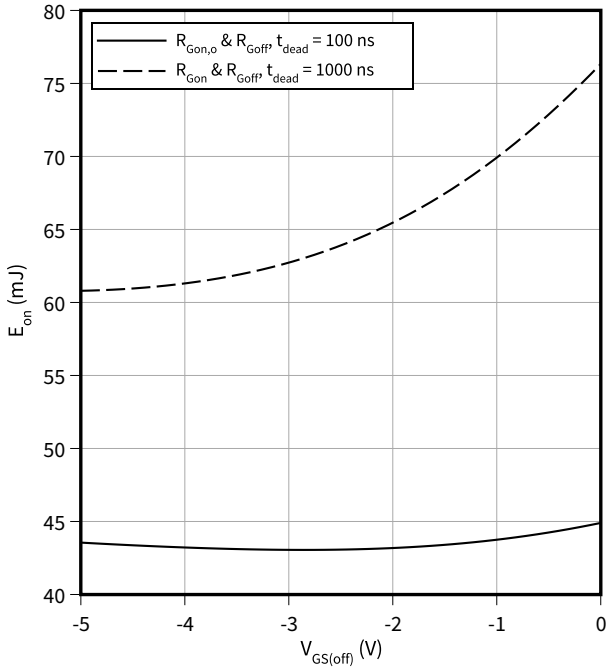
V_{DD} = 750 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 850 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E_{on} = f(V_{GS(off)})$

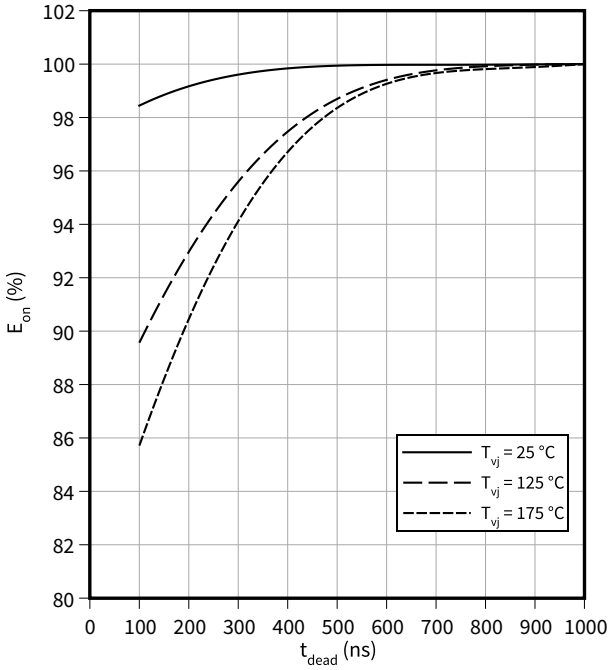
R_{Goff} = 1 Ω, V_{DD} = 750 V, R_{Gon} = 4.7 Ω, $V_{GS(on)}$ = 18 V, I_D = 850 A, $R_{Gon,o}$ = 3.9 Ω, T_{vj} = 175 °C



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E_{on} = f(t_{dead})$

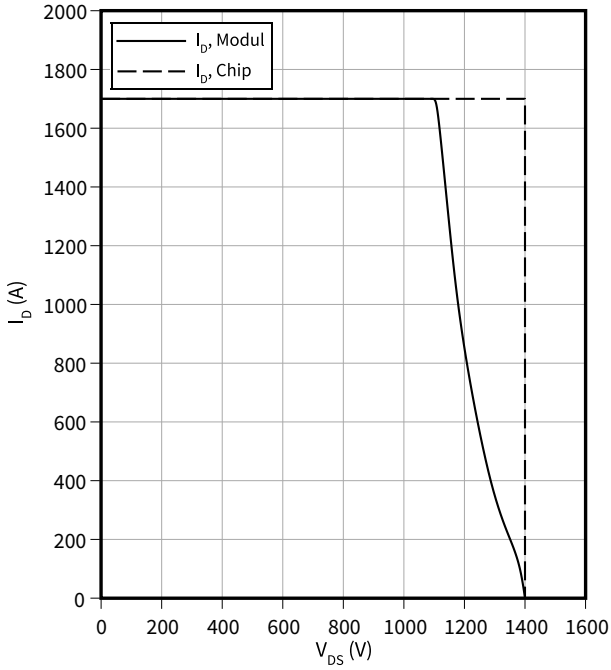
R_{Gon} = 4.7 Ω, I_D = 850 A, V_{DD} = 750 V, V_{GS} = -3/18 V



Reverse bias safe operating area (RBSOA), MOSFET

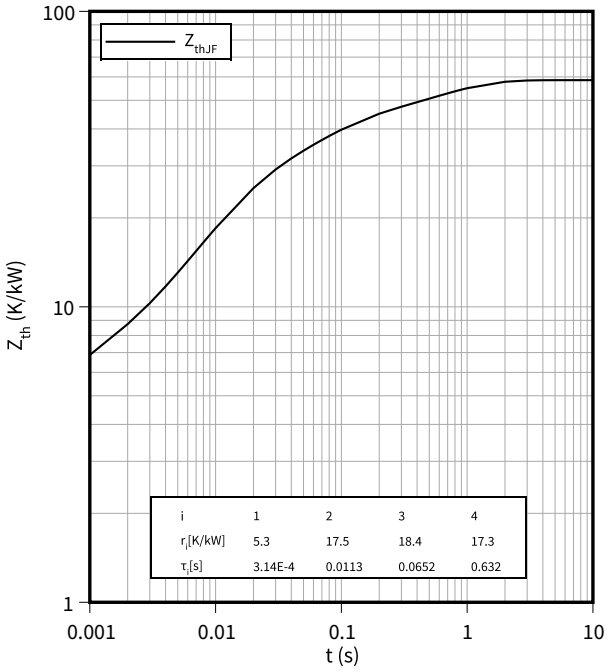
$I_D = f(V_{DS})$

R_{Goff} = 1 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Transienter Wärmewiderstand, MOSFET

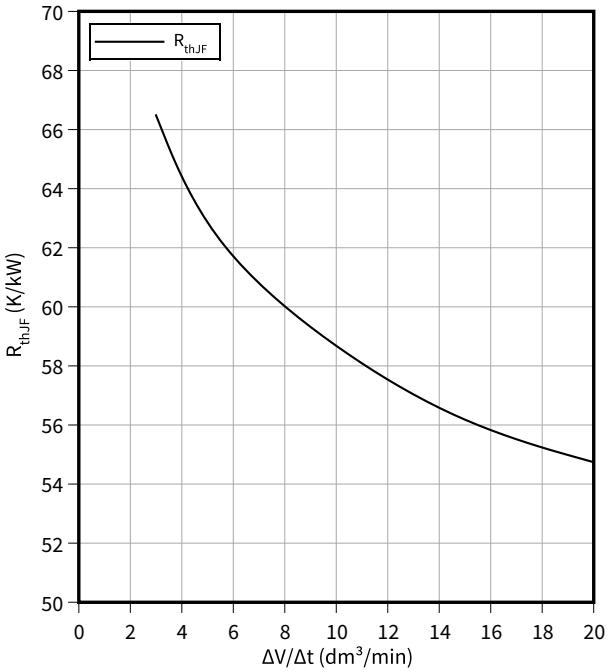
$Z_{th} = f(t)$



Wärmewiderstand, MOSFET

$R_{thJF} = f(\Delta V/\Delta t)$

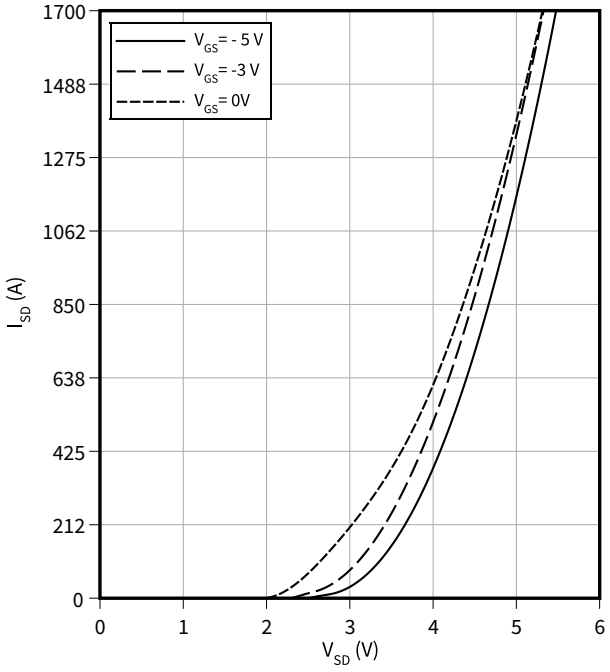
T_F = 60 °C, 50% water / 50% ethylene glycol



Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET

$I_{SD} = f(V_{SD})$

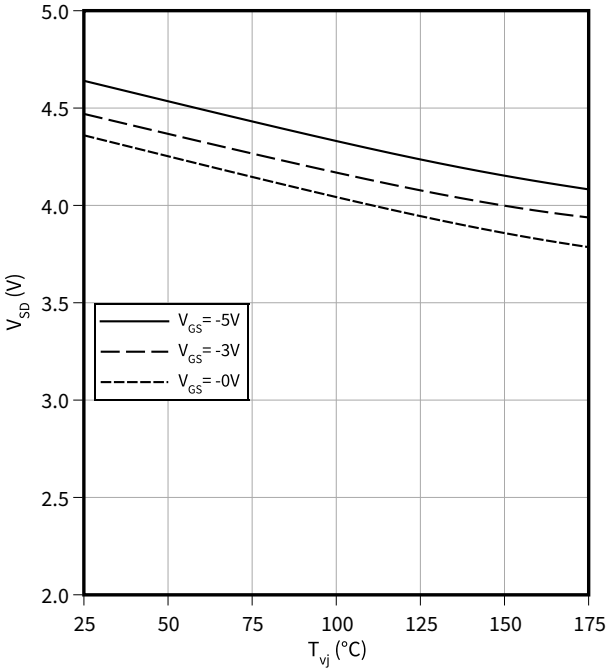
T_{vj} = 25 °C



Durchlassspannung der Body-Diode (typisch), MOSFET

$V_{SD} = f(T_{vj})$

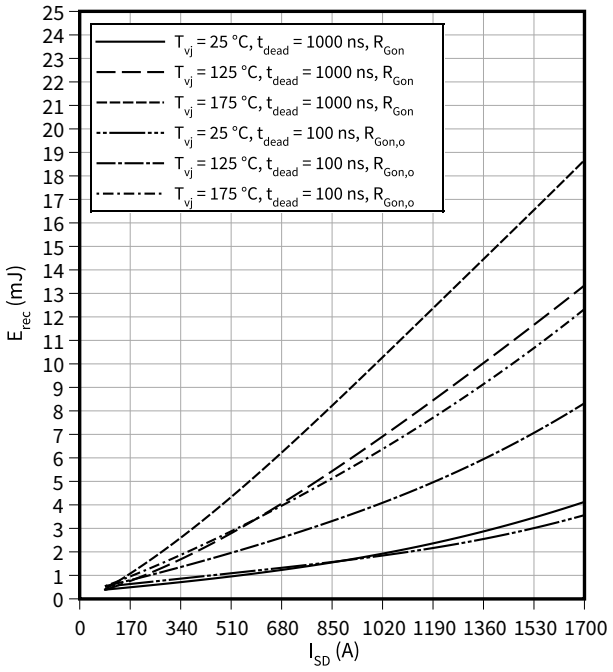
I_{SD} = 850 A



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET

$E_{rec} = f(I_{SD})$

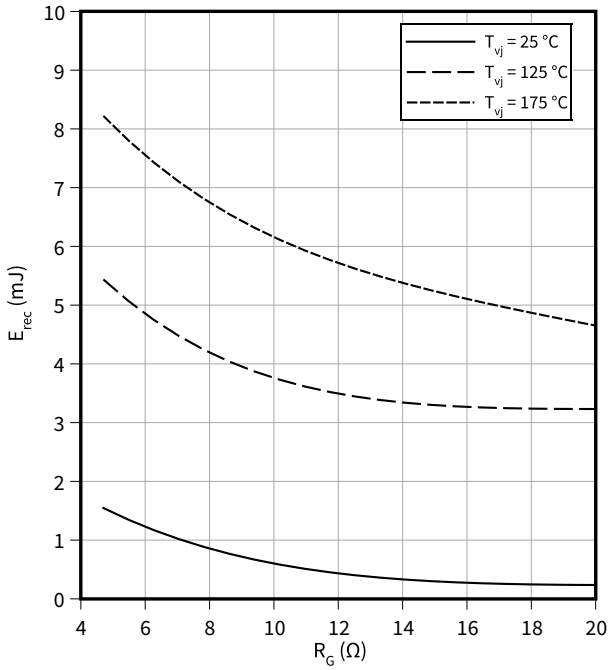
$R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $R_{Gon,o} = 3.9\ \Omega$, $V_{DD} = 750$ V



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET

$E_{rec} = f(R_G)$

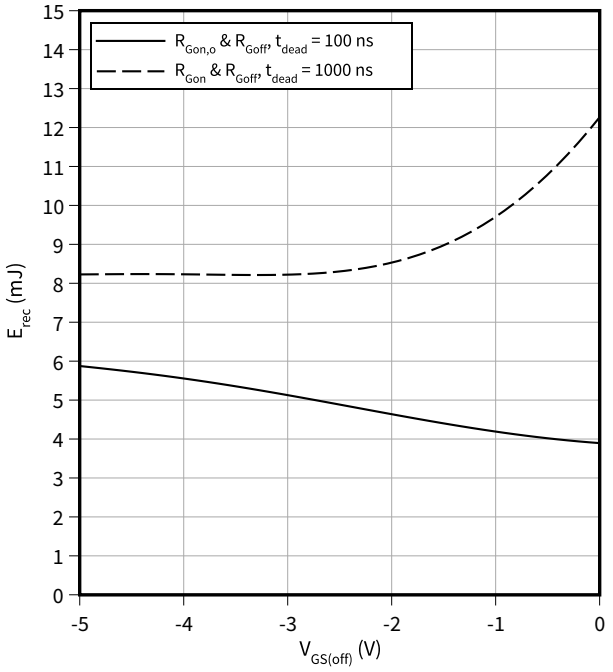
$t_{dead} = 1000$ ns, $I_{SD} = 850$ A, $V_{DD} = 750$ V



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET

$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$

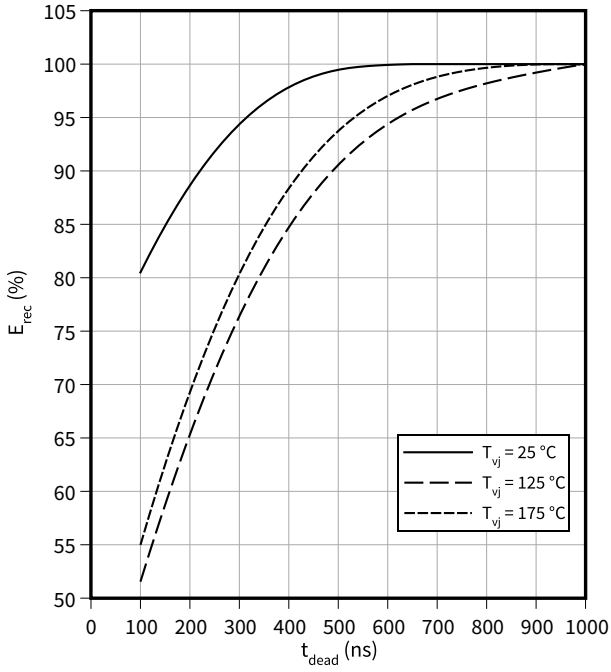
$R_{Goff} = 1\ \Omega$, $R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $V_{GS(on)} = 18$ V, $I_{SD} = 850$ A,
$R_{Gon,o} = 3.9\ \Omega$, $V_{DD} = 750$ V, $T_{vj} = 175$ °C



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET

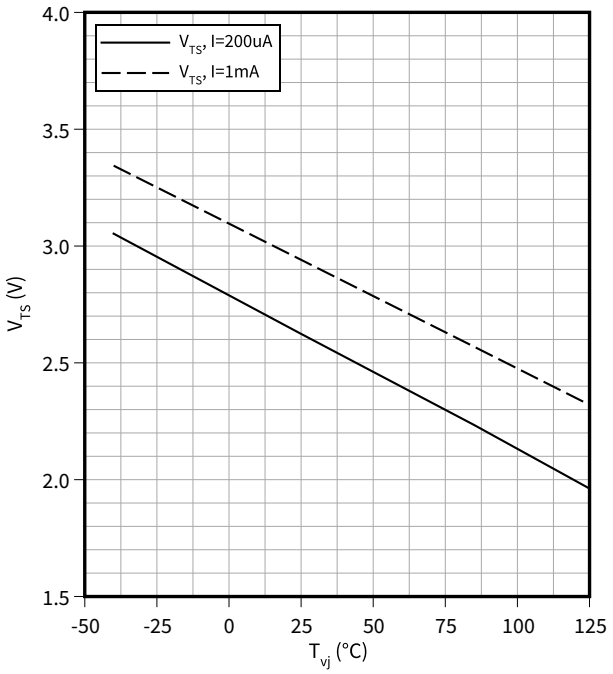
$E_{rec} = f(t_{dead})$

$R_{Gon} = 4.7\ \Omega$, $I_D = 850$ A, $V_{DD} = 750$ V, $V_{GS} = -3/18$ V



Temperature characteristic (typical), Temperatursensor

$V_{TS} = f(T_{vj})$



6 Schaltplan

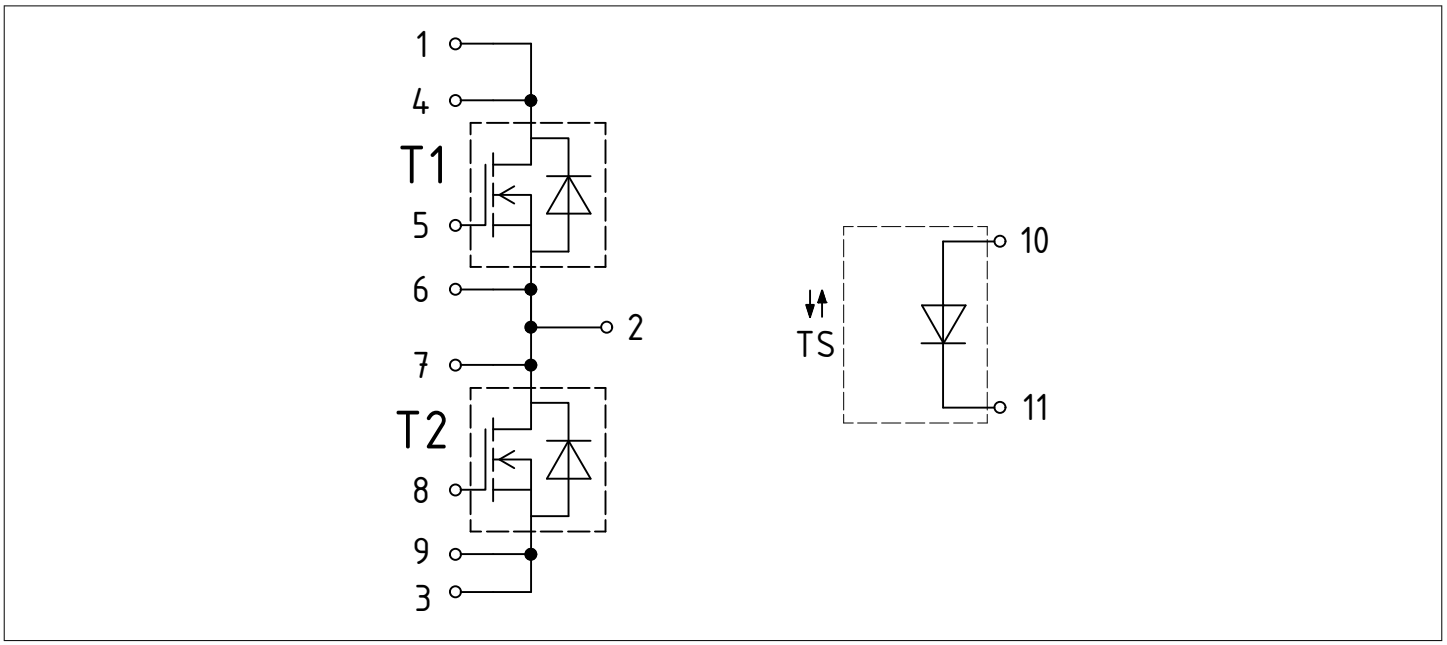


Abbildung 1

7 Gehäuseabmessungen

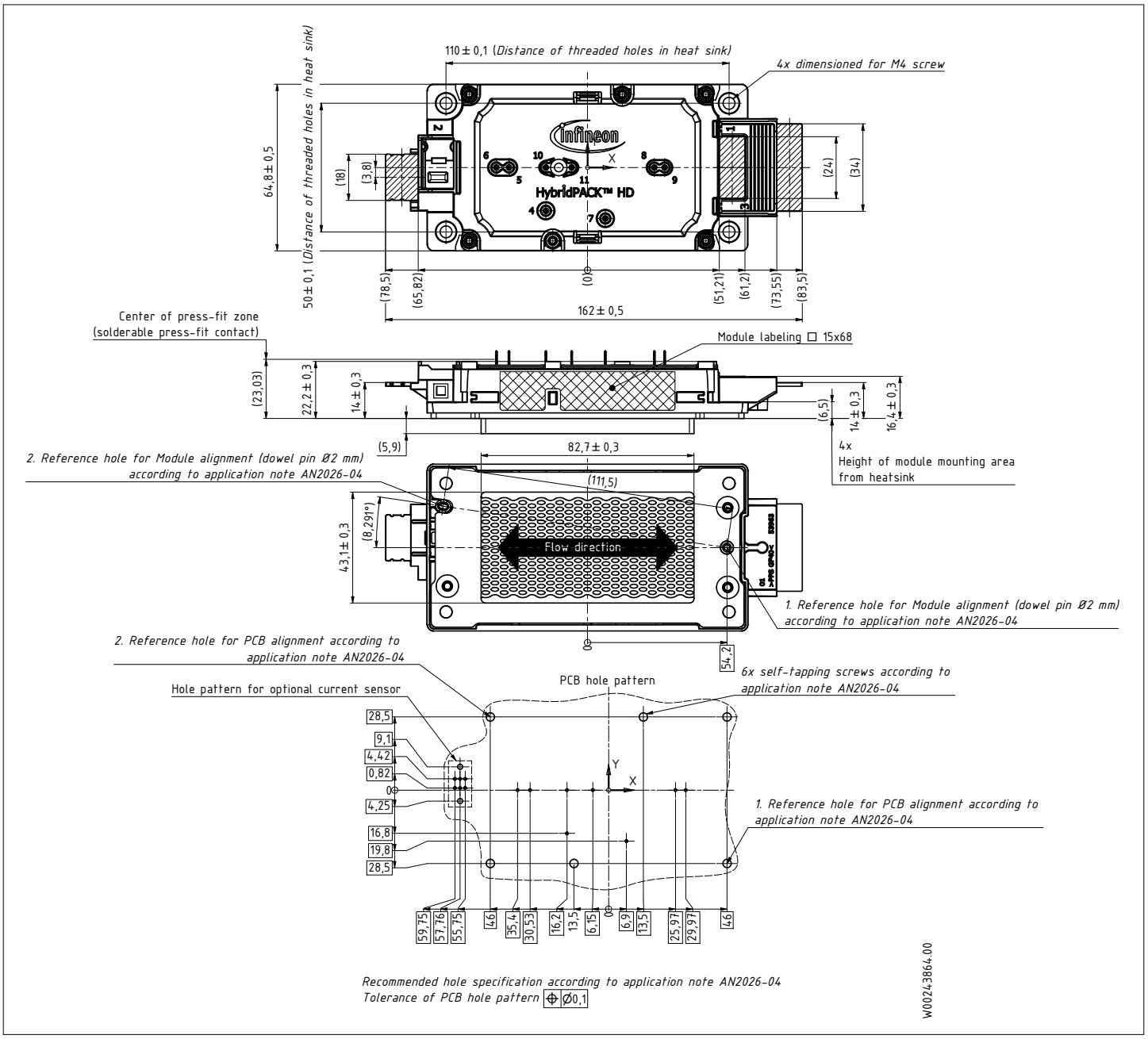


Abbildung 2

8 Modul-Label-Code

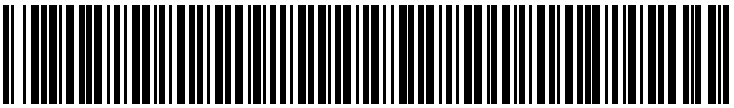
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 7154914284655054991530	 7154914284655054991530	

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2024-07-12	Target datasheet
0.20	2025-09-05	Preliminary datasheet
0.21	2026-01-20	Preliminary datasheet - update
1.00	2026-06-03	Final datasheet
1.01	2026-10-09	General update
1.02	2026-10-19	General update

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-19

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2026 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABL075-006

Wichtiger Hinweis

Produkte, die auch Muster enthalten bzw. aus Hardware oder Software oder beidem bestehen können ("Produkt(e)"), werden von der Infineon Technologies AG und ihren verbundenen Unternehmen ("Infineon") zu den Bedingungen des Rahmenliefervertrags oder anderer schriftlicher Vereinbarungen zwischen einem Kunden und Infineon oder, in Ermangelung dessen, zu den geltenden Verkaufsbedingungen von Infineon verkauft oder bereitgestellt und geliefert. Allgemeine Geschäftsbedingungen eines Kunden oder Abweichungen von den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Infineon sind für Infineon nur dann verbindlich, wenn und soweit Infineon ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

Infineon übernimmt keine Verantwortung für Informationen in Bezug auf Muster, die Anwendung oder die spezifische Verwendung eines Produkts durch den Kunden oder für Beispiele oder typische Werte in diesem Dokument.

Sofern dieses Dokument als „Draft“, „Preliminary“, „Target“, oder „Proposal” gekennzeichnet ist, behält sich Infineon das Recht vor, alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vorbehaltlich der Entwicklung und Freigabe eines Produkts zur Serienlieferung durch Infineon sind die technischen Spezifikationen des Produkts in dem entsprechenden Datenblatt von Infineon ohne diese Kennzeichnung aufgeführt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch qualifizierte und erfahrene Kundenmitarbeiter/-innen bestimmt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung und den spezifischen Einsatz des Kunden zu beurteilen und alle in diesem Dokument enthaltenen relevanten technischen Daten für die beabsichtigte Anwendung und den spezifischen Einsatz des Kunden zu überprüfen. Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Gestaltung, Programmierung und Prüfung der Funktionalität und Sicherheit der beabsichtigten Anwendung sowie für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Verwendung verantwortlich.

Sofern nicht ausdrücklich von Infineon genehmigt, dürfen die Produkte nicht in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen zu erwarten ist, dass ein Versagen der Produkte oder die Folgen ihrer Verwendung zu Personenschäden führen können.

Das Vorstehende gilt jedoch nicht den Kunden nicht daran hindern, ein Produkt in solchen Einsatzbereichen zu verwenden, für die Infineon es ausdrücklich entwickelt und verkauft hat, vorausgesetzt, die Gesamtverantwortung für die Anwendung liegt beim Kunden.

Infineon behält sich ausdrücklich das Recht vor, seine Inhalte für kommerzielles Text- und Data-Mining (TDM) gemäß den geltenden Gesetzen, z. B. § 44b UrhG, zu nutzen.

Sofern das Produkt Sicherheitsfunktionen enthält gilt Folgendes:

Da kein datenverarbeitendes Produkt absolut sicher sein kann trotz der im Produkt implementierten Sicherheitsmaßnahmen, garantiert Infineon nicht, dass das Produkt frei von Störungen, Datendiebstahl oder -verlust oder anderen Verstößen ("Sicherheitsverstöße") ist, und Infineon übernimmt keine Haftung für Sicherheitsverstöße.

Wenn dieses Dokument Software enthält oder darauf verweist:

Die Software ist Eigentum von Infineon und unterliegt den Gesetzen und Verträgen über geistiges Eigentum der Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschlands und anderer Länder weltweit. Alle Rechte sind vorbehalten. Vor diesem Hintergrund darf der Kunde die Software nur gemäß dem für die Software geltenden Softwarelizenzvertrag verwenden. Wenn kein Softwarelizenzvertrag vorliegt, gewährt Infineon dem Kunden hiermit eine persönliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz (ohne das Recht auf Unterlizenzierung) unter seinen geistigen Eigentumsrechten (a) die Software, die in Quellcodeform bereitgestellt wird, zur ausschließlichen Verwendung mit Infineon-Hardwareprodukten zu modifizieren bzw. zu vervielfältigen, und zwar nur intern innerhalb der Organisation des Kunden, und (b) die Software in Binärcodeform extern an Endnutzer zu vertreiben, und zwar ausschließlich für die Verwendung mit Infineon-Hardwareprodukten. Jede andere Verwendung, Reproduktion, Änderung, Übersetzung oder Zusammenstellung der Software ist untersagt.

Weitere Informationen über das Produkt, die Technologie, die Verkaufsbedingungen von Infineon und die Preise kann der Kunde entweder bei der Infineon-Niederlassung in seiner Nähe erhalten oder unter www.infineon.com.